

(19) REPUBLIC OF FRANCE

**NATIONAL INSTITUTE
OF INDUSTRIAL PROPERTY**

PARIS

(11) Publication number: **2 797 347**
(to be used only when
ordering copies)

(21) National registration number: **99 10121**

(51) Int. Cl.⁷: H 01 L 21/304, H 01 L 21/324

(12)

PATENT APPLICATION

A1

(22) Date filed: August 4, 1999
(30) Priority:

(43) Date application was made available to the
public: February 9, 2001, 01/06 Journal.

(56) List of documents cited in the preliminary
search report: Refer to the end of the present
document.

(60) References to other related national documents:

(71) Applicant(s): *ATOMIC ENERGY COMMISSION,
a Scientific, Technical and Industrial Establishment – FR*

(72) Inventor(s): Chrystelle LAGAHE, Alain SOUBIE,
Michel BRUEL and Bernard ASPAR.

(73) Patent holder(s):

(74) Legal Representative: Brevatome

(54) TRANSFER PROCESS FOR A THIN FILM COMPRISING AN OVER-FRAGILIZATION STEP

(57) Process for transferring a thin film (18) of a source
substrate (10) towards a target support (30) consisting
of the following steps:

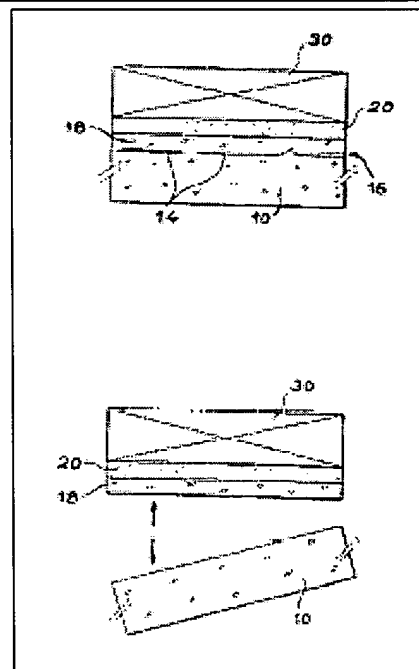
a) an implantation of ions or gaseous substances
into the source substrate in order to form an area (16),
called the cleavage area, which traces out the said thin
film (18) in the source substrate.

b) the layout of the source substrate on the target
support and the consolidation of the thin film with the
target support,

c) the separation of thin film (18) from the source
substance (10) along the cleavage area.

In compliance with the invention, the process prior to
step b) includes:

- an over-fragilization of cleavage area (16), caused
by thermal treatment and/or exertion of mechanical
forces on the source substrate.



THIS PAGE BLANK (USP 10)

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 797 347

②1 N° d'enregistrement national : 99 10121

⑤1 Int Cl⁷ : H 01 L 21/304, H 01 L 21/324

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 04.08.99.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 09.02.01 Bulletin 01/06.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO-
MIQUE Etablissement de caractère scientifique techni-
que et industriel — FR.

⑦2 Inventeur(s) : LAGAHE CHRYSTELLE, SOUBIE
ALAIN, BRUEL MICHEL et ASPAR BERNARD.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : BREVATOME.

⑤4 PROCÉDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE COMPORTANT UNE ÉTAPE DE SURFRAGILISATION.

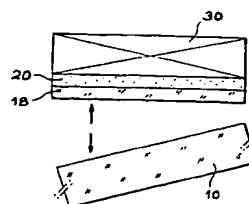
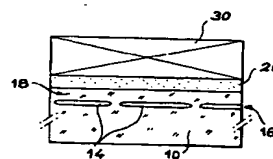
⑤7 Procédé de transfert d'une couche mince (18) d'un
substrat source (10) vers un support cible (30) comportant
les étapes suivantes:

a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans
le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de
clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le sub-
strat source,

b) le report du substrat source sur le support cible et la
solidarisation de la couche mince avec le support cible,

c) la séparation de la couche mince (18) d'avec le sub-
strat source (10) selon la zone de clivage,
conformément à l'invention le procédé comporte préala-
blement à l'étape b):

- une surfragilisation de la zone de clivage (16) provo-
quée par un traitement thermique et/ ou par l'exercice d'ef-
forts mécaniques sur le substrat source.



FR 2 797 347 - A1



**PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE COMPORTANT UNE
ETAPE DE SURFRAGILISATION**

Domaine technique

La présente invention concerne un procédé de
5 transfert d'une couche mince d'un substrat, dit
substrat source, vers un support appelé support cible.

L'invention trouve des applications en
particulier dans les domaines de la micro-électronique,
de la micro-mécanique, de l'optique intégrée et de
10 l'électronique intégrée.

Elle permet, par exemple de réaliser des
structures dans lesquelles la couche mince, qui est en
un matériau sélectionné pour ses propriétés physiques,
est reportée sur un support afin de former un
15 empilement à plusieurs couches. Ainsi, on peut combiner
les avantages des matériaux de la couche mince et du
support. Le report d'une couche permet notamment
d'associer dans une même structure des parties qui
présentent a priori des incompatibilités telles qu'une
20 différence importante de coefficients de dilatation
thermique.

Etat de la technique antérieure

Le texte qui suit se réfère à un certain nombre
25 de documents dont les références complètes sont
précisées à la fin de la description.

Parmi les procédés généralement mis en oeuvre
pour la formation de couches minces, on peut citer en
particulier un procédé de clivage, bien connu sous la
30 dénomination "Smart-cut", et illustré par le document
(1).

Le procédé "Smart-cut" est basé essentiellement sur l'implantation d'hydrogène ou d'un autre gaz sous forme neutre ou ionique dans un substrat de façon à y former une zone de clivage fragilisée.

5 Dans le cas d'un substrat plan, la zone de clivage s'étend, de façon sensiblement parallèle à sa surface et est située dans le substrat à une profondeur fixée par l'énergie d'implantation. La zone de clivage délimite ainsi dans le substrat une couche
10 superficielle mince qui s'étend en épaisseur depuis la zone de clivage jusqu'à la surface du substrat.

Une deuxième étape comprend la mise en adhérence du substrat source avec un support cible de telle façon que la couche mince soit solidaire du
15 support cible. La fixation de la couche mince sur le support cible peut avoir lieu au moyen d'une colle et/ou par l'intermédiaire d'une couche de liaison. Elle peut avoir lieu également par adhérence moléculaire directe entre la surface du substrat et la surface du
20 support cible.

Dans ce dernier cas, il est cependant nécessaire que les faces que l'on souhaite faire adhérer présentent certaines propriétés comme une bonne planéité et une faible rugosité.

25 Une dernière étape du procédé consiste à fracturer le substrat selon la zone de clivage pour en séparer la couche mince. Celle-ci reste alors solidaire du support cible.

Dans le cas du procédé décrit par le document
30 (1), la fracture (ou clivage) du substrat est provoquée

par apport d'énergie sous forme d'un traitement thermique.

Les conditions d'implantation définissent la zone de clivage et conditionnent la séparation de la
5 couche mince d'avec le substrat.

Or, on a observé qu'une trop grande fragilisation de la zone de clivage après l'implantation, bien que favorable pour la séparation, provoque des déformations de la surface de la couche
10 mince. Les déformations se présentent sous la forme de cloques et constituent un obstacle pour la fixation de la couche mince sur le support cible.

Cette trop grande fragilisation, peut être liée à une implantation ionique à forte dose ou à une
15 implantation ionique à plus faible dose associée à un recuit. La trop grande fragilisation peut donc induire l'apparition de cloques en surface d'autant plus facilement que la zone fragilisée est proche de la surface.

20 Dans certaines applications on souhaite obtenir des films minces autoportés, c'est-à-dire qui peuvent être séparée du substrat source sans être préalablement fixés sur un support.

Ces films minces peuvent alors être reportés
25 ultérieurement sur différents supports cibles et, en particulier, sur des supports avec lesquels le substrat source ne peut pas être mis en adhérence avant la séparation de la couche mince, par exemple, pour des raisons de compatibilité des coefficients de dilatation
30 thermique.

On peut à ce sujet se reporter au document (2) qui propose un procédé dérivé de celui du document (1).

Le document (2) propose un procédé permettant d'obtenir la séparation de son substrat d'origine, d'un
5 film mince qui est autoporté. Pour cela, il faut que les espèces gazeuses implantées se trouvent à une profondeur suffisante et/ou que l'on dépose, après l'étape d'implantation, une couche d'un matériau permettant de rigidifier la structure pour obtenir la
10 séparation au niveau de la zone implantée sans avoir de cloques.

L'illustration de la technique de formation d'une couche mince par clivage d'un substrat, peut être complétée par le document (3) qui suggère de compléter
15 le traitement thermique de fracture (clivage) du substrat par l'exercice de forces mécaniques de flexion, de traction et/ou de cisaillement.

Le document (4) qui décrit également un procédé basé sur le principe établi par le document (1), montre
20 que le budget thermique mis en oeuvre pour provoquer la fracture du substrat source dépend des budgets thermiques de tous les traitements thermiques imposés au substrat source depuis l'implantation jusqu'à la fracture.

25 On entend par budget thermique le couple durée de traitement thermique/température de traitement thermique.

Dans un certain nombre d'applications il est nécessaire d'assembler une couche mince d'un substrat
30 source avec un support cible qui présente un

coefficient de dilatation thermique différent de celui du substrat source.

Dans ces applications, il est généralement délicat de soumettre la structure obtenue après
5 assemblage du substrat source et du support cible, à un traitement thermique avec un budget thermique suffisant pour garantir la séparation de la couche mince d'avec le substrat source.

Une solution à ce problème consiste alors à
10 modifier les conditions d'implantation en effectuant un surdosage des espèces implantées. Un tel surdosage permet en effet de réduire le budget thermique de la fracture de séparation (clivage).

A titre d'exemple, lorsque le substrat source
15 est une plaque de silicium, une dose d'ions d'hydrogène implantés, de $1.10^{17}/\text{cm}^2$ au lieu de $6.10^{16}/\text{cm}^2$, permet pour une durée de traitement thermique de quelques heures d'en abaisser la température de 400°C à 280°C .

La solution consistant à surdoser
20 l'implantation n'est cependant pas toujours satisfaisante en raison de la différence de coefficient de dilatation thermique pouvant exister entre le substrat et le support. En effet, le budget thermique nécessaire à la séparation peut être tel qu'il provoque
25 le décollement du substrat et du support et/ou la cassure du substrat et/ou du support dans leur volume.

Une solution alternative pour éviter un décollement entre la couche mince et le support cible sous l'effet d'une dilatation différentielle, consiste
30 à amincir le substrat source avant l'étape de fracture (clivage).

Cette solution, suggérée par le document (5), présente toutefois l'inconvénient d'une opération supplémentaire d'amincissement et celui d'une consommation de matière importante.

5 La mise en oeuvre de forces mécaniques pour séparer le substrat source de la couche mince, telle qu'évoquée ci-dessus en référence au document (3), permet également de réduire le budget thermique de fracture, notamment dans le cas où les matériaux en
10 contact présentent des coefficients de dilatation différents. L'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source et/ou le support cible n'est toutefois pas toujours possible, notamment lorsque les matériaux
15 mis en oeuvre sont fragiles, ou lorsque la zone de clivage n'est pas assez fragilisée par l'implantation ionique.

 Finalement, les techniques de séparation et de transfert de couche mince, décrites ci-dessus, impliquent un certain nombre de contraintes et de
20 compromis. Ces contraintes sont imposées en particulier par le type de matériaux utilisés pour constituer le substrat source, la couche mince et le support cible.

Exposé de l'invention

25 La présente invention a pour but de proposer un procédé de transfert d'une couche mince, ne présentant pas les difficultés et limitations des procédés indiquées ci-dessus.

 Un but est en particulier de proposer un tel
30 procédé qui mette en oeuvre un budget thermique réduit

voir nul pour obtenir une fracture de séparation de la couche mince.

Un autre but est de proposer un procédé adapté au transfert d'une couche mince sur un support cible, dans lequel les matériaux de la couche mince et du support cible présentent des coefficients de dilatation thermique différents.

Encore un autre but est de proposer un procédé de transfert dans lequel un excellent état de surface du substrat source (sans cloques) peut être préservé de façon à autoriser une bonne adhérence avec le support cible, avec ou sans apport de liant (colle), et en permettant d'avoir une zone de clivage très fragilisée.

Enfin, un but de l'invention est de proposer un procédé de transfert permettant d'obtenir, après transfert, une couche mince sur le support cible, qui présente une surface libre avec une faible rugosité.

Pour atteindre ces buts, l'invention a plus précisément pour objet un procédé de transfert d'une couche mince d'un substrat source vers un support cible comportant, dans l'ordre, les étapes suivantes :

- a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone, dite de clivage, qui délimite ladite couche mince dans le substrat source,
- b) le report du substrat source sur le support cible et la solidarisation de la couche mince avec le support cible,
- c) la séparation de la couche mince d'avec le substrat source selon la zone de clivage.

Conformément à l'invention, le procédé comporte préalablement à l'étape b),

- une formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, 5 égale ou voisine d'une épaisseur limite pour laquelle le film est autoporté, et

- une surfragilisation de la zone de clivage provoquée par un traitement thermique et/ou par 10 l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, l'étape de formation d'une épaisseur de film consiste à réaliser l'étape a) d'implantation de façon à obtenir la zone de clivage à ladite épaisseur, 15 le film étant alors constitué par la couche mince.

Selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, l'étape de formation d'une épaisseur de film consiste à réaliser une étape de formation d'une couche dite d'épaississeur sur la couche mince, la 20 couche mince et la couche d'épaisseur formant alors le film.

L'épaisseur limite du film est l'épaisseur permettant de rigidifier la structure pour obtenir la séparation du film au niveau de la zone de clivage sans 25 apparition en surface de cloques. C'est cette épaisseur limite qui permet d'obtenir des films autoportés. Cette épaisseur dépend en particulier des propriétés mécaniques des matériaux, mais aussi des conditions de séparation de l'étape c) telle que par exemple la 30 montée en température du traitement thermique.

Selon un mode avantageux, l'invention comporte également la réalisation, avant l'étape b), de tout ou partie de composants micro-électriques et/ou micro-mécaniques et/ou optoélectroniques.

5 La séparation de la couche mince d'avec le substrat source, opérée à l'étape c), peut avoir lieu sous l'effet d'un traitement thermique, sous l'effet d'efforts mécaniques ou sous l'effet de ces actions combinées.

10 Or, grâce à l'étape de surfragilisation, le budget thermique et/ou les efforts mécaniques mis en oeuvre lors de l'étape c) pour la fracture de séparation peuvent être particulièrement réduits. Ceci a pour avantage de ne pas provoquer de rupture
15 d'adhérence entre le film mince et le support cible, même en cas d'une différence des coefficients de dilatation thermique des matériaux mis en contact.

Un autre avantage de l'invention est de supprimer ou réduire les efforts mécaniques exercés sur
20 les parties en contact et éviter ainsi de les détériorer. On facilite ainsi la séparation.

Il convient de noter que l'étape de surfragilisation n'induit pas de contraintes de dilatation différentielle dans la mesure où cette étape
25 est effectuée avant le report du substrat source sur le support cible (étape b).

Selon un aspect avantageux, la surfragilisation comporte un traitement thermique mis en oeuvre avec un budget thermique supérieur ou égal à 50%, et de
30 préférence supérieur à 60%, d'un budget thermique global permettant la séparation.

Le budget thermique global considéré ici prend en compte non seulement les traitements thermiques opérés dans le strict cadre du procédé de l'invention, mais comprend également d'éventuels traitements
5 thermiques mis en oeuvre, par exemple, pour la réalisation de composants ou pour le dépôt de matériaux sur la couche mince entre les étapes a) et b).

Comme évoqué précédemment, les étapes c) et l'étape de surfragilisation peuvent comporter un
10 exercice d'efforts mécaniques.

Ces efforts mécaniques comprennent, par exemple, l'application de forces sous la forme d'une pression mécanique et/ou d'une tension mécanique et/ou des forces sous la forme d'une pression de gaz.

15 Le traitement thermique de séparation peut aussi être choisi suffisant pour provoquer lors de l'étape c) une séparation de la couche mince, par simple écartement du substrat source et du support cible.

20 L'étape d'implantation a) permet de former dans le substrat source des cavités situées dans la zone de clivage.

Les cavités (ou micro-cavités ou platelets ou microbulles) peuvent se présenter sous différentes
25 formes. Elles peuvent être sphériques et/ou aplaties avec une épaisseur de seulement quelques distances inter-atomiques. Par ailleurs, les cavités peuvent contenir une phase gazeuse libre et/ou des atomes de gaz issus des ions implantés, fixés sur les atomes du
30 matériau formant les parois des cavités.

Les traitements thermiques subis par le support source, et en particulier un traitement thermique de surfragilisation du procédé, conduisent à la coalescence de tout ou partie des cavités. La
5 coalescence provoque ainsi la surfragilisation du substrat dans la zone de clivage.

Ce phénomène permet en outre d'obtenir, après le report et la fracture de séparation, une surface libre de la couche mince avec une faible rugosité.

10 La couche d'épaisseur, par exemple en Si, SiO_2 , Si_3N_4 ou encore SiC, recouvre la couche mince en tout ou partie. L'épaisseur de la couche d'épaisseur pour obtenir une épaisseur de film est choisie par exemple dans une gamme allant de 3 à 10 μm pour un
15 épaisseur SiO_2 .

Il convient de préciser qu'une couche utilisée comme couche d'épaisseur peut être une couche qui sert également en tout ou partie à la réalisation de composants électroniques, optoélectroniques, ou
20 mécaniques à la surface de la couche mince.

L'invention concerne également un procédé de transfert d'une couche mince d'un substrat source comportant les étapes suivantes :

- a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans
25 le substrat source de façon à y former une zone, dite de clivage, qui délimite ladite couche mince dans le substrat source,
- b) la séparation de la couche mince d'avec le substrat source selon la zone de clivage,
- 30 conformément à l'invention, le procédé comporte en outre, préalablement à l'étape b) :

- une formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le
5 film soit autoporté, et

- une surfragilisation de la zone de clivage provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

10 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, en référence aux figures des dessins annexés. Cette description est donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

15

Brève description des figures

- La figure 1 est une coupe schématique d'un substrat source et illustre une opération d'implantation d'ions.

20 - La figure 2 est une coupe schématique du substrat source de la figure 1 et illustre la formation d'une couche d'épaisseur.

- La figure 3 est une coupe schématique du substrat source de la figure 2 et illustre une étape de
25 fragilisation.

- La figure 4 est une coupe schématique d'une structure formée du substrat source de la figure 3, reporté sur un support cible.

30 - La figure 5 est une coupe schématique de la structure de la figure 4 après fracture de séparation du substrat source.

Description détaillée d'un mode de mise en oeuvre de l'invention

La description qui suit se rapporte à un
5 transfert d'une couche mince de silicium sur un support cible de silice fondue (appelée abusivement quartz).

L'invention peut cependant être mise en oeuvre pour d'autres matériaux solides, qu'ils soient cristallins ou non. Ces matériaux peuvent être
10 diélectriques, conducteurs, semi-isolants ou semi-conducteurs.

De même, le support cible peut être un support final ou intermédiaire, tel qu'une poignée, un substrat massif ou un substrat multicouche.

15 Le procédé peut en particulier être mis à profit pour le report de couches de LiNbO_3 ou de semi-conducteurs III-V tel que AsGa, InP sur du silicium ou du SiC.

La figure 1 montre un substrat initial 10 en
20 silicium. Celui-ci subit une implantation d'ions hydrogène indiquée avec des flèches 12. Cette implantation correspond à l'étape a_1) du procédé.

L'implantation, effectuée par exemple avec une dose de $6.10^{16}/\text{cm}^2$ et une énergie de 70 keV, permet de
25 former des microcavités 14 dans le substrat 10 à une profondeur de l'ordre de 7000 Å.

Cette profondeur correspond également à l'épaisseur d'une couche mince 18. Celle-ci est délimitée à la surface du substrat par une zone 16,
30 dite de clivage, comprenant les microcavités 14.

Antérieurement ou de préférence postérieurement à cette implantation, la couche mince superficielle 18 peut être soumise à d'autres traitements, connus en soi, pour la formation dans cette couche de composants
5 électroniques, optiques, ou mécaniques. Ces composants ne sont pas représentés sur la figure pour des raisons de clarté.

De même, pour une meilleure lisibilité des figures, les différentes couches ou caractéristiques
10 représentées, ne le sont pas selon une échelle uniforme. En particulier, les couches très minces sont représentées avec une épaisseur exagérée.

La figure 2 qui correspond à l'étape d'utilisation d'un épaisseur du procédé, montre le
15 dépôt d'une couche d'oxyde de silicium 20 d'une épaisseur de l'ordre de, ou supérieure à 5 μm , sur la couche mince 18. La couche d'oxyde de silicium est par exemple déposée par un procédé de dépôt chimique en phase gazeuse assisté par plasma à une température de
20 300°C.

La couche d'oxyde de silicium 20 a un rôle d'épaississeur de la couche mince 18. En d'autres termes, elle a pour fonction de prévenir une déformation de la couche mince sous l'effet de
25 traitements thermiques ultérieurs.

La figure 3 correspond à l'étape de surfragilisation du procédé. Lors de cette étape, le substrat subit des traitements visant à fragiliser davantage encore la zone de clivage 16.

30 Dans l'exemple illustré, on procède à un traitement thermique effectué à une température de

l'ordre de 450°C pendant une durée de l'ordre de 12 minutes.

Ce budget thermique est de préférence supérieur à 60% du budget thermique nécessaire pour obtenir une
5 séparation uniquement par recuit. Une telle surfragilisation est possible avec une épaisseur suffisante de film.

On observe que le traitement thermique provoque une coalescence partielle des microcavités 14 de la
10 zone de clivage 16.

Lors de cette opération, la couche de d'épaisseur 20 qui recouvre la couche mince 18, prévient sa déformation et en particulier prévient la formation de cloques.

15 En l'absence de cette couche, des cloques seraient susceptibles d'apparaître avec un traitement thermique à 450°C après une durée de l'ordre de 2 minutes ce qui correspond uniquement à un traitement thermique de 10% du traitement thermique nécessaire à
20 la séparation.

Le traitement thermique peut être suivi par une étape de polissage de la face libre de la couche d'épaississeur 20 juste pour améliorer la rugosité de surface de façon à la préparer pour un collage
25 moléculaire.

La figure 4 montre le report du substrat source 10 sur un support cible 30 qui, en l'occurrence, est une plaque de quartz.

Le report est effectué de façon à mettre en
30 contact une face plane du support cible avec la face plane libre de la couche d'épaississeur 20.

Des forces d'adhérence moléculaire s'exerçant au niveau des faces mises en contact assurent la solidarisation (fixation) entre le substrat source et le support cible.

5 Lorsqu'une telle adhérence moléculaire n'est pas possible pour des raisons de nature des matériaux ou de qualité des surfaces, le report peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un liant ou d'une colle.

10 Les forces d'adhérence moléculaire peuvent être renforcées par exemple par un traitement thermique et/ou par des préparations de surface. Dans l'exemple illustré, et en raison des fortes différences de coefficients de dilatation thermique entre le silicium et le quartz, le traitement thermique est effectué à
15 une température relativement basse, de l'ordre de 200°C pendant une durée de 20 heures.

Ce traitement thermique peut contribuer à induire des contraintes telles que la fracture du substrat peut être obtenue selon cette zone.

20 La figure 5 illustre l'étape c) du procédé qui correspond à une fracture du substrat source. La fracture a lieu selon la zone de clivage et sépare la couche mince 18 de la partie restante du substrat 10. Cette dernière partie peut alors être réutilisée par
25 exemple pour un nouveau transfert de couche mince.

La couche mince 18 reste solidaire du support 30 par l'intermédiaire de la couche d'épaisseur 20.

Dans un autre exemple, non représenté, où l'épaisseur de la couche mince est assez importante
30 pour éviter des déformations, la couche d'épaisseur

peut être omise. La couche mince est alors directement en contact avec le support cible.

A titre d'exemple, on peut citer l'utilisation d'un substrat en SiC, qui est implanté à environ
5 200 KeV de façon à obtenir un film sans épaisseur, d'environ 1,5 μm . Dans cet exemple, la surfragilisation peut être obtenue sans épaisseur.

La fracture du substrat source peut être provoquée par l'exercice d'une force mécanique et/ou
10 par un traitement thermique.

Dans l'exemple illustré, une lame de rasoir (non représentée) peut être insérée à la main au niveau de la zone fragilisée.

L'invention s'applique particulièrement bien à
15 la réalisation d'une couche mince de silicium sur de la silice fendue dont l'intérêt principal est d'avoir un support transparent avec une couche de semi-conducteur pouvant comporter des composants.

20 DOCUMENTS CITES

(1) FR-A-2 681 472 (US-A-5 374 564)

(2) FR-A2 738 671 (US-A-5 714 395)

25

(3) FR-A-2 748 851

(4) FR-A-2 767 416

30 (5) FR-A-2 755 537

REVENDICATIONS

1. Procédé de transfert d'une couche mince (18) d'un substrat source (10) vers un support cible (30) comportant les étapes suivantes :

- 5 a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le substrat source,
- 10 b) le report du substrat source sur le support cible et la solidarisation de la couche mince avec le support cible,
- c) la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) selon la zone de clivage, caractérisé en ce qu'il comporte préalablement à
- 15 l'étape b) :
- la formation d'une épaisseur de film de matériau entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le film soit
 - 20 autoporté, et
 - une surfragilisation de la zone de clivage (16) provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

25 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) est provoquée par un traitement thermique et/ou par l'exercice de forces mécaniques.

30 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel la surfragilisation comporte un traitement

thermique mis en oeuvre avec un budget thermique permettant la séparation.

4. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le traitement thermique de séparation est choisi
5 suffisant pour provoquer, lors de l'étape c), une séparation de la couche mince (18), par simple écartement du substrat source et du support cible.

5. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'étape c) et l'étape de surfragilisation
10 comportent l'exercice de forces sous la forme d'une pression mécanique et/ou une tension mécanique et/ou des forces sous la forme d'une pression de gaz.

6. Procédé de transfert d'une couche mince (18)
d'un substrat source (10) comportant les étapes
15 suivantes :

a) une implantation d'ions ou d'espèces gazeuses dans le substrat source de façon à y former une zone (16), dite de clivage, qui délimite ladite couche mince (18) dans le substrat source,
20 b) la séparation de la couche mince (18) d'avec le substrat source (10) selon la zone de clivage, caractérisé en ce qu'il comporte préalablement à l'étape b) :

- une formation d'une épaisseur de film de matériau
25 entre la zone de clivage et la surface du substrat telle que cette épaisseur soit supérieure, égale ou voisine d'une épaisseur limite pour que le film soit autoporté, et
- une surfragilisation de la zone de clivage (16)
30 provoquée par un traitement thermique et/ou par

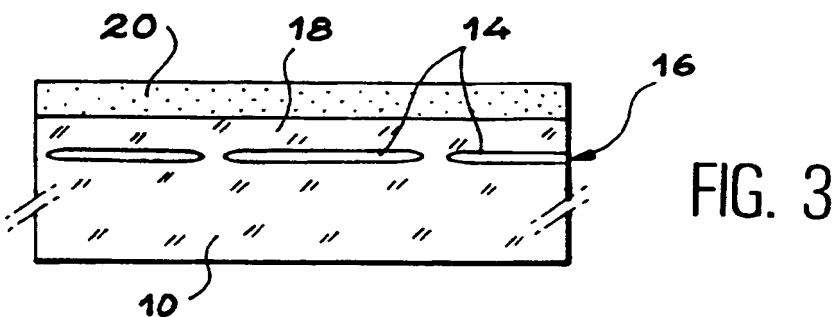
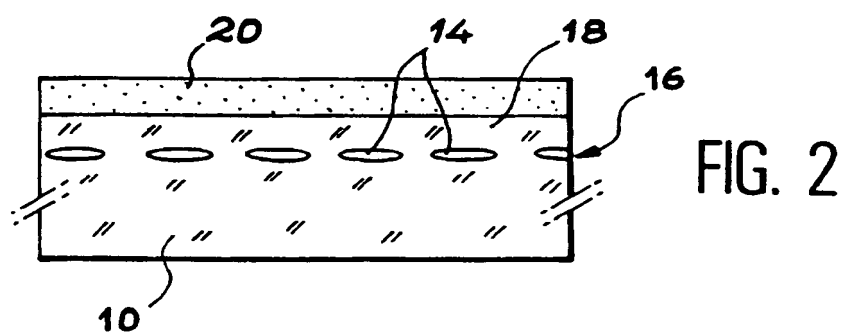
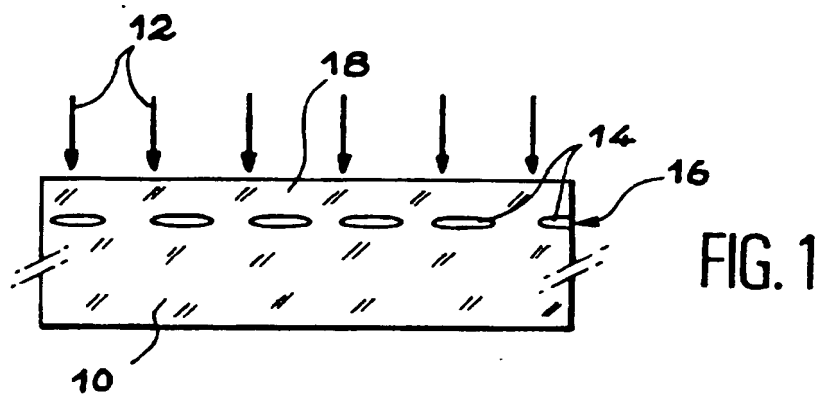
l'exercice d'efforts mécaniques sur le substrat source.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de formation d'une
5 épaisseur de film consiste à réaliser l'étape a) d'implantation de façon à obtenir la zone de clivage à ladite épaisseur, le film étant alors constitué par la couche mince.

8. Procédé selon la revendication 1, dans
10 lequel l'étape de formation d'une épaisseur de film comprend la réalisation d'une couche dite d'épaississeur (20) sur la couche mince, la couche mince et la couche d'épaississeur formant alors le film.

15 9. Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre la réalisation, avant l'étape b), de tout ou partie de composants micro-électroniques et/ou micro-mécaniques et/ou opto-électroniques.

1 / 2



2 / 2

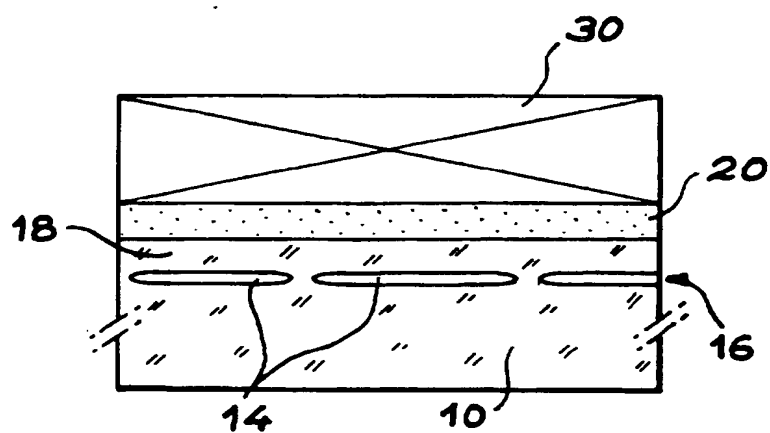


FIG. 4

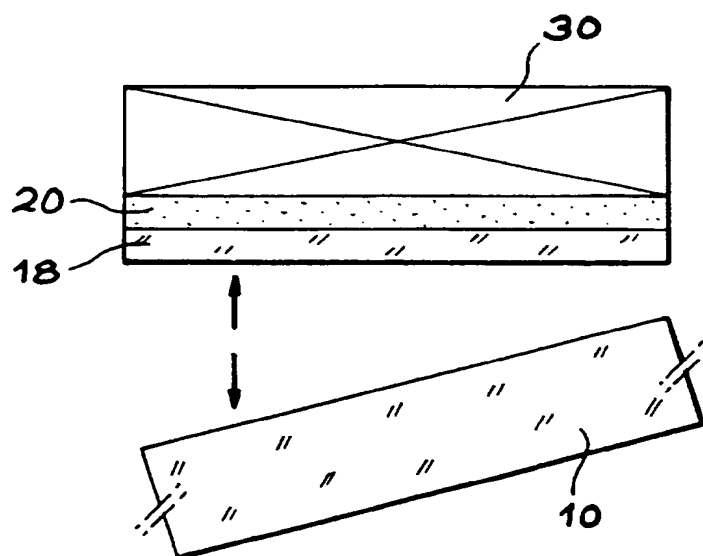


FIG. 5

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE**
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 579841
FR 9910121

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US 5 877 070 A (TONG Q-Y ET AL) 2 mars 1999 (1999-03-02) * abrégé; revendications *	1-4,6,7
X	EP 0 807 970 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 novembre 1997 (1997-11-19) * abrégé; revendications; figures * * colonne 6, ligne 17 - colonne 7, ligne 26 *	1-4,6,7, 9
A	EP 0 763 849 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 19 mars 1997 (1997-03-19) * abrégé; revendications; figures *	1,2,4, 6-8
A	US 5 909 627 A (EGLOFF RICHARD) 1 juin 1999 (1999-06-01) * abrégé; revendications; figures *	1,6
A	EN W G ET AL: "THE GENESIS PROCESSTM: A NEW SOI WAFER FABRICATION METHOD" ANNUAL IEEE INTERNATIONAL SILICON-ON-INSULATOR CONFERENCE, US, NEW YORK, NY: IEEE, vol. CONF. 24, 1998, pages 163-164, XP000830696 ISBN: 0-7803-4501-0 * abrégé; figure 1 *	1,6
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL7)
		H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
30 mars 2000		Wirner, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

2

EPO FORM 1503 02.92 (P04C13)